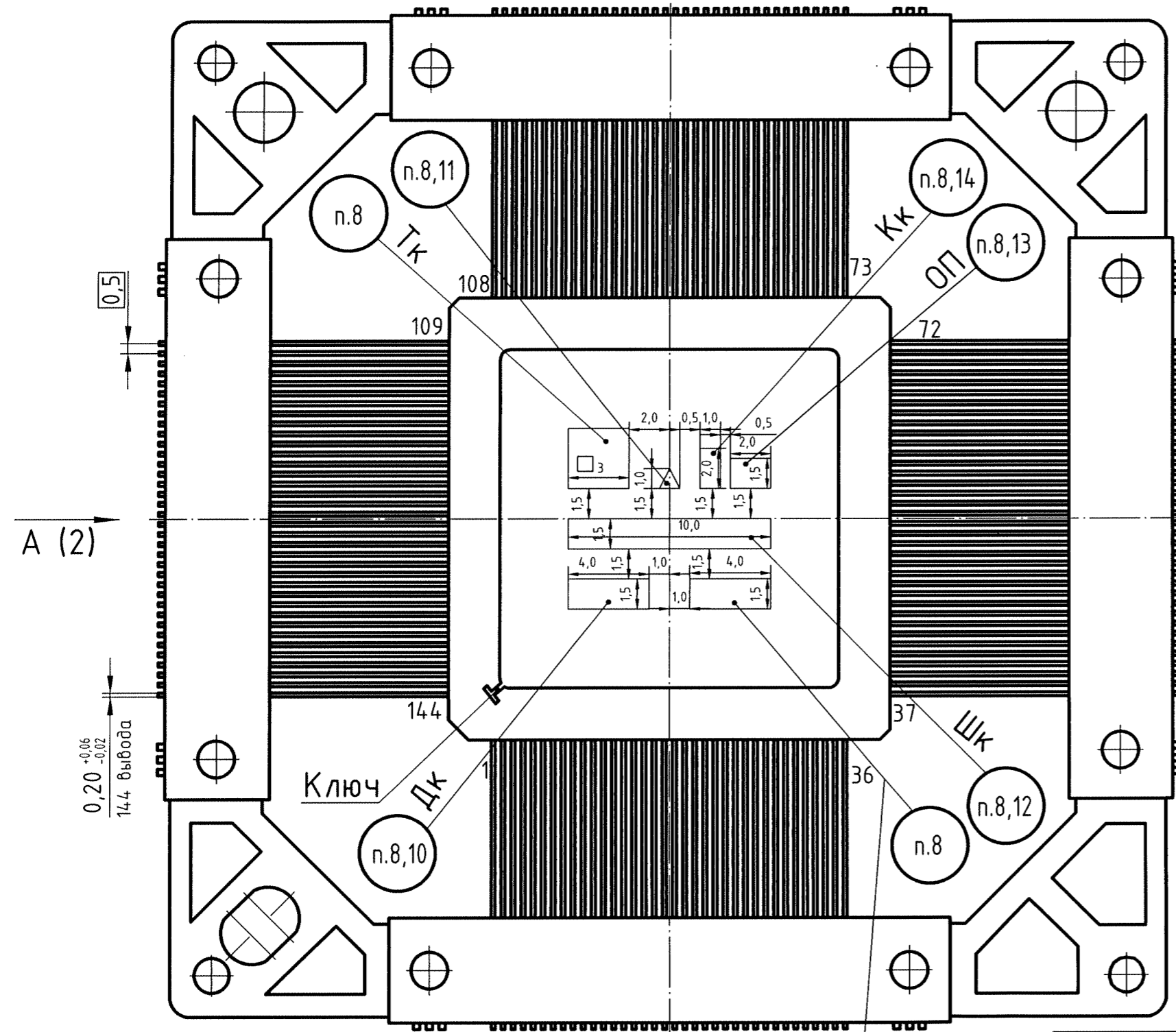


Г АВЛ.431268.016СБ

Рис.1 (Г АВЛ.431268.016)

(см. продолжение на листах 2, 3)



1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеит к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$.
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать состав маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно основному виду. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
9. Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
10. С обратной стороны маркировать согласно виду Б для микросхемы 5529ТР054, виду Ж для 5529ТР054А.
11. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
12. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
13. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
14. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
15. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
16. Нумерация выводов приведена условно.
17. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР054 соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.016ЭТ, 5529ТР054А - Г АВЛ.431268.016-01ЭТ.
18. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

Инв. № подл. 1569
 Подп. и дата 20.01.20
 Взам. инв. № Инв. № дубл.
 Подп. и дата
 Справ. № Г АВЛ.431268.016
 Перв. примен.

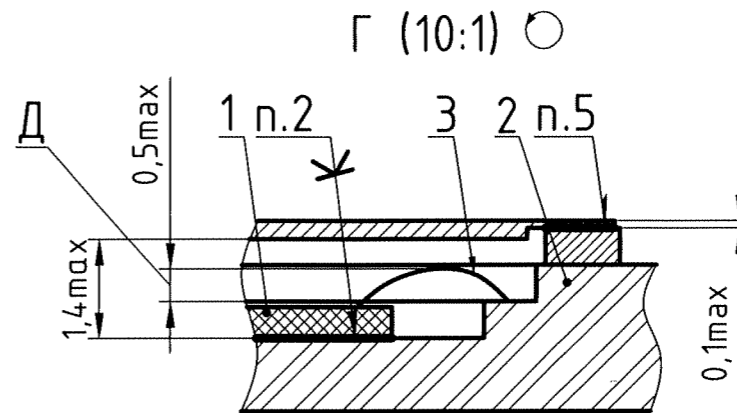
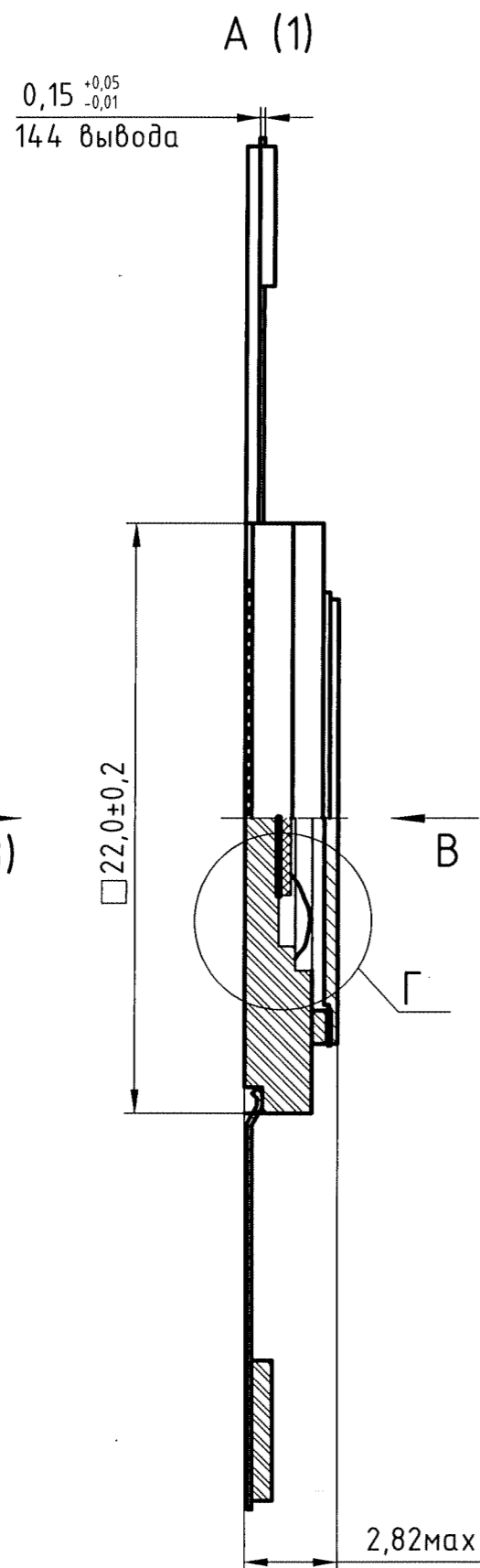
Таблица 1 - Модификация

Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
Г АВЛ.431268.016	5529ТР054	МК 4248.144-3	5529ТР054	мах 7,5 г	1
-01	5529ТР054А	МК 4247.100-3	5529ТР054А	мах 5,5 г	2

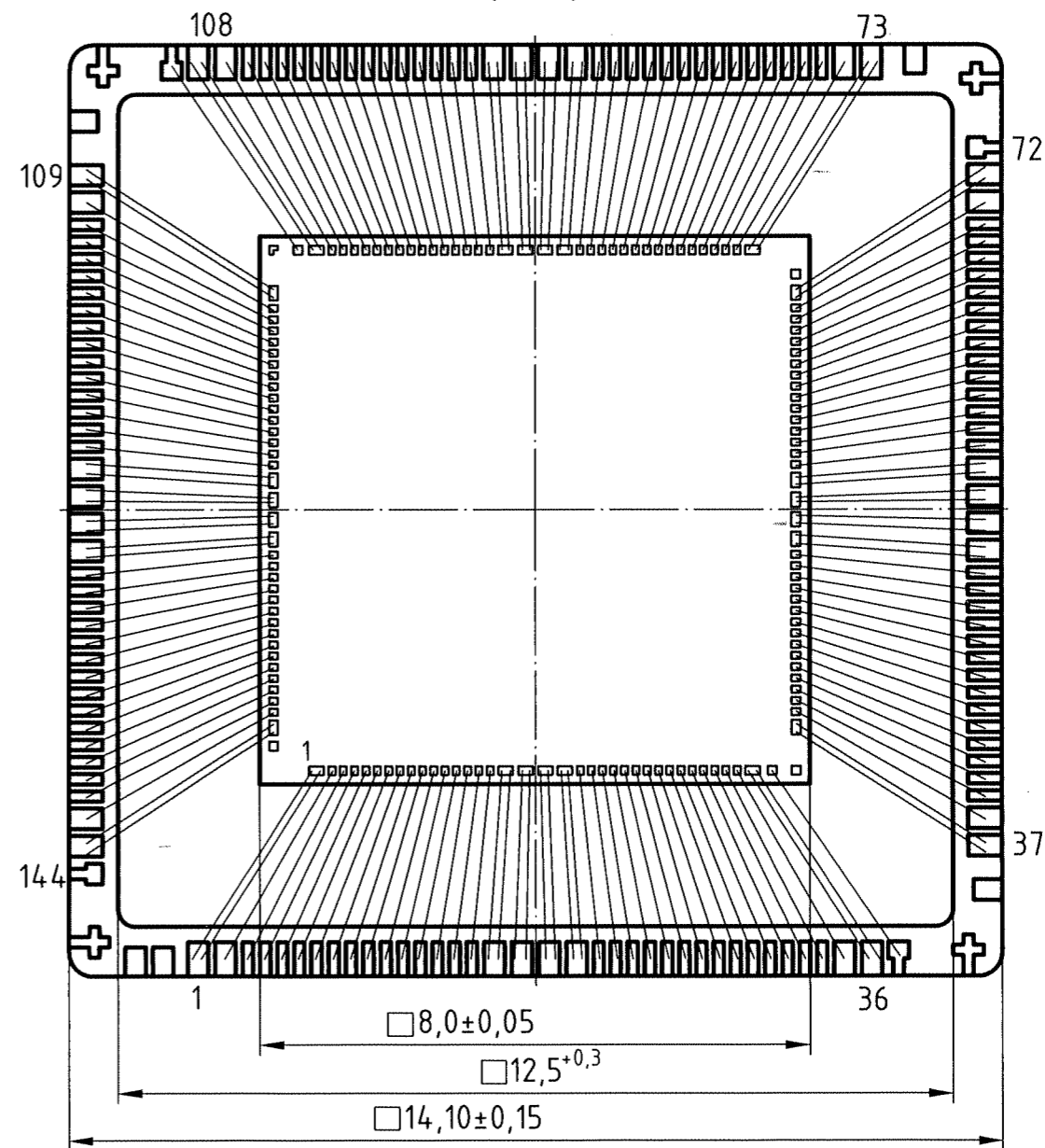
Регистрационный номер карты заказа

				Г АВЛ.431268.016СБ				
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>af</i>	09.11.19	Микросхемы интегральные 5529ТР054, 5529ТР054А Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докum.	Подп.	Дата		A	-	4:1
Разраб.	Астахова		<i>af</i>	13.11.19		Лист 1	Листов 5	
Пров.	Тукашкин		<i>af</i>	13.11.19				
512 ВП	Чириченко		<i>af</i>	13.11.19				
Н.контр.	Казаков		<i>af</i>	13.11.19				
Утв.	Денисов		<i>af</i>	13.11.19				

Рис.1 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.016)



Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны
В (10:1)



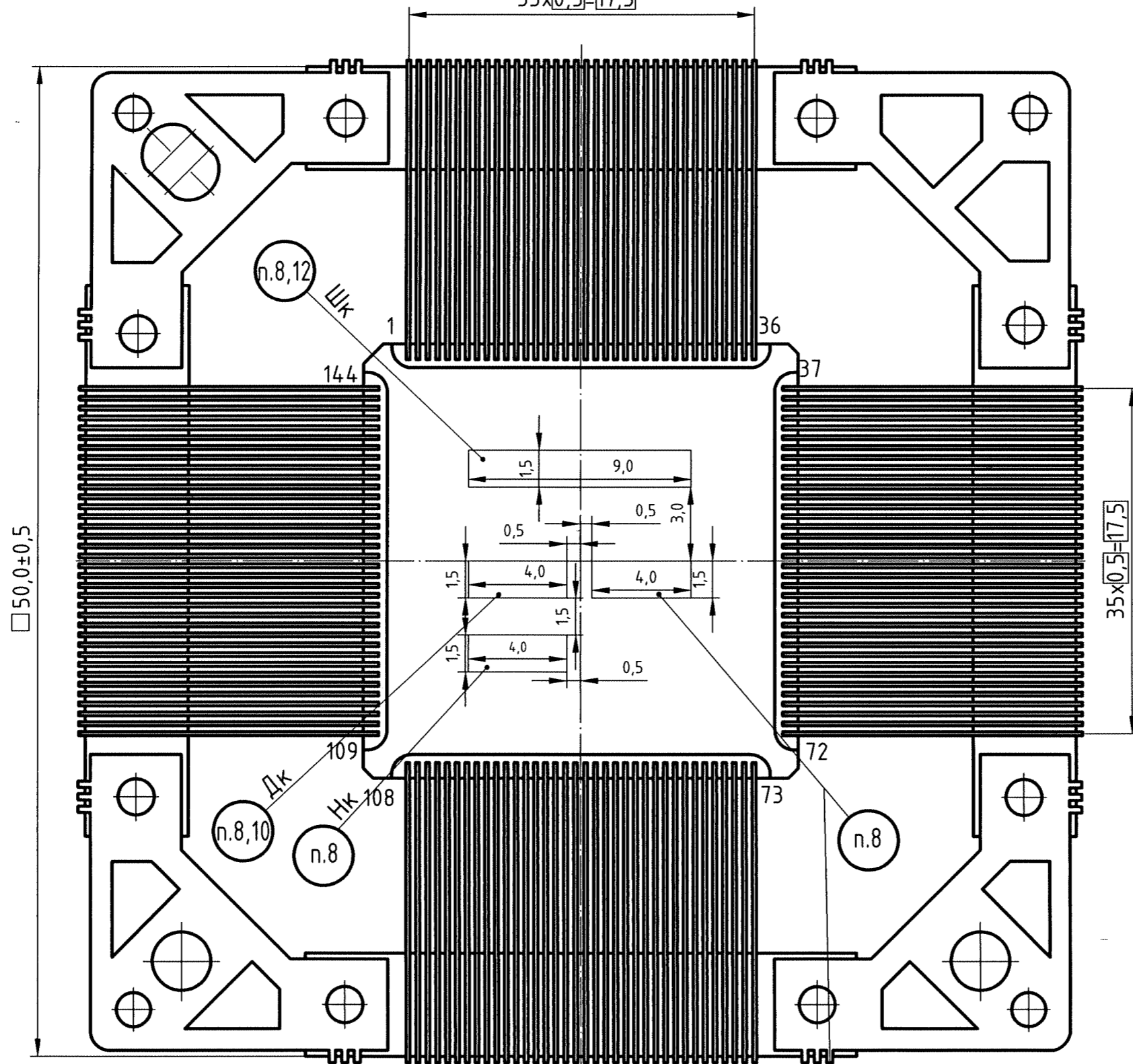
Инв. № подл.	1509
Подп. и дата	Сур 20.01.2019
Взам. инв. №	Инв. № дцдл
Подп. и дата	Подп. и дата

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Сур	20.01.19
Изм./Лист	№	Докум.	Подп.	Дата

Рис.1 (продолжение)
(ГВЛ.431268.016)

Б (2) ○

35x0,5=17,5



Регистрационный
номер карты заказа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	дцбл	Подп. и дата
1569	Def 02.01.20				

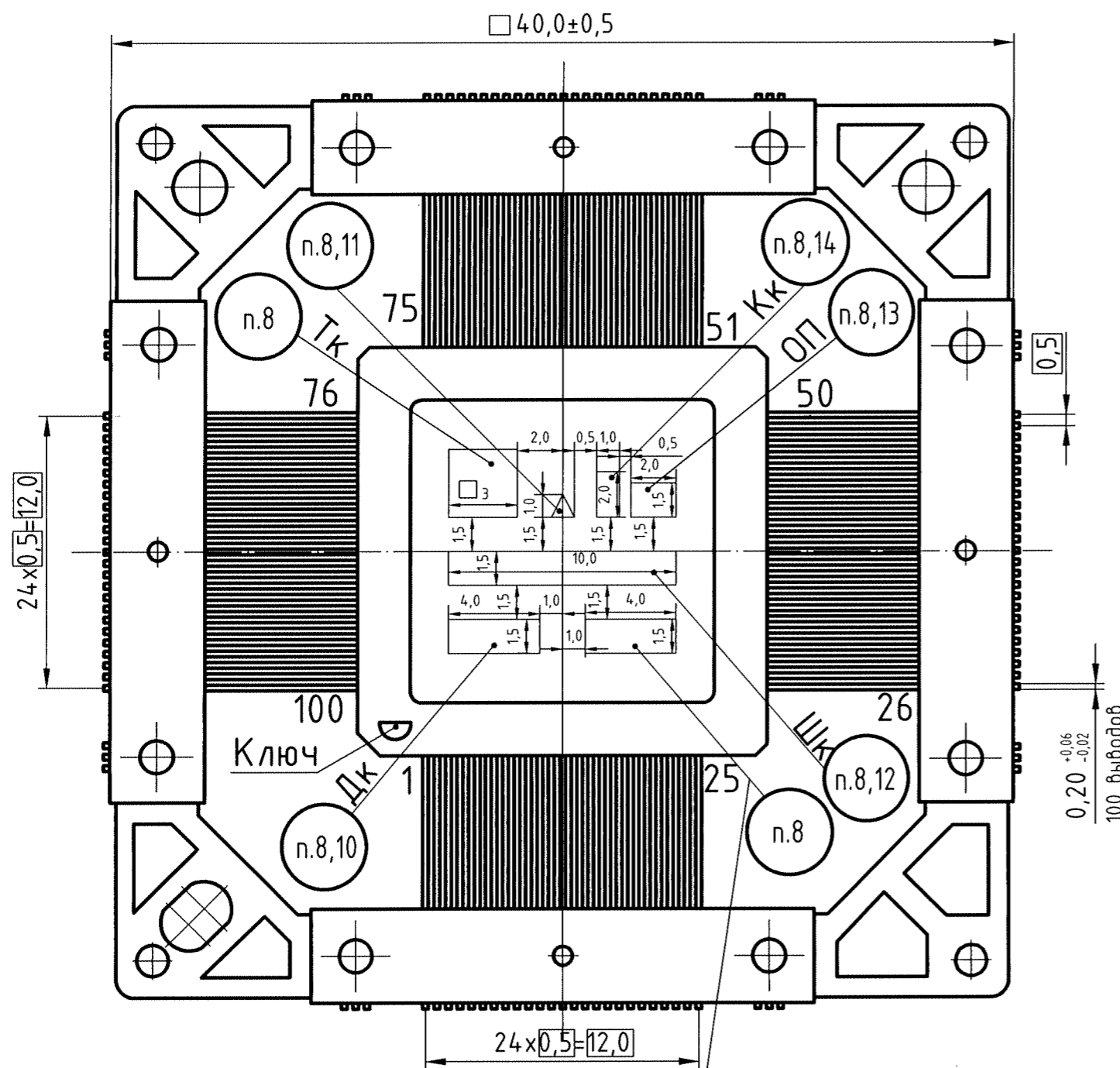
1	Зам.	ГВЛ.09-2019	Def 09.11.19
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп. Дата

ГВЛ.431268.016СБ

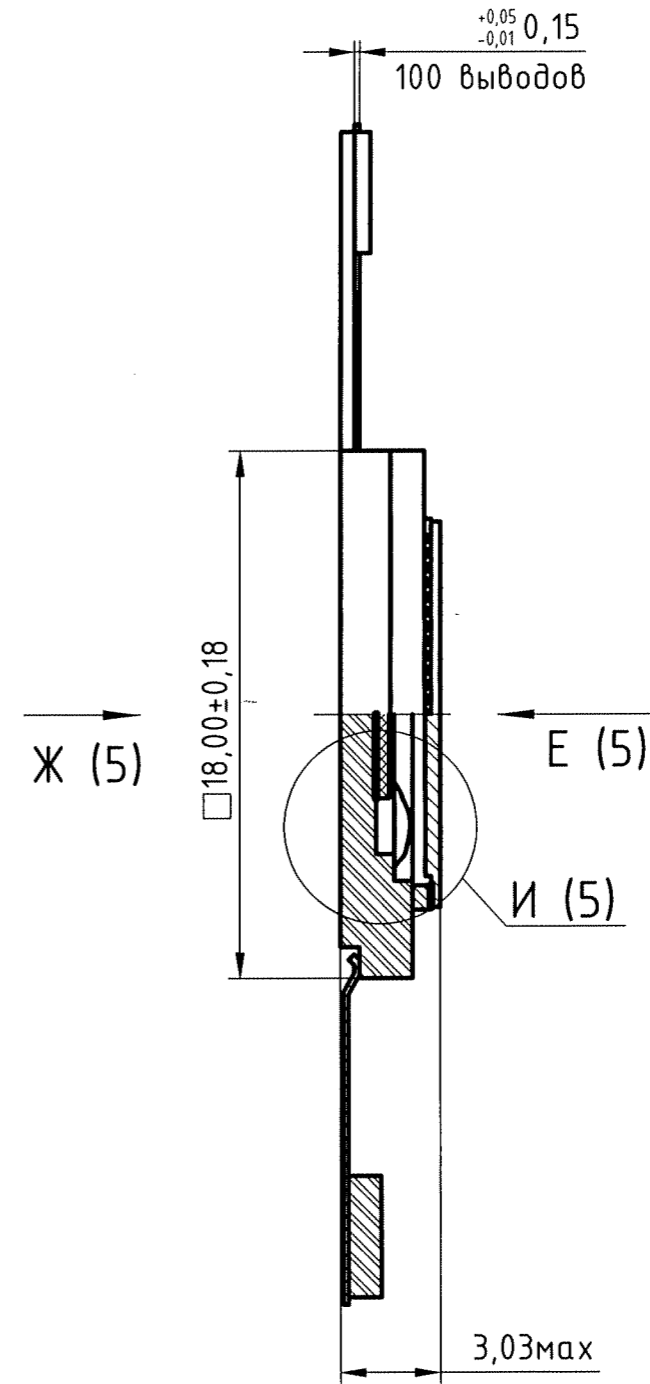
Лист
3

Рис.2 (Г АВЛ.431268.016-01)

(см. продолжение на листе 5)



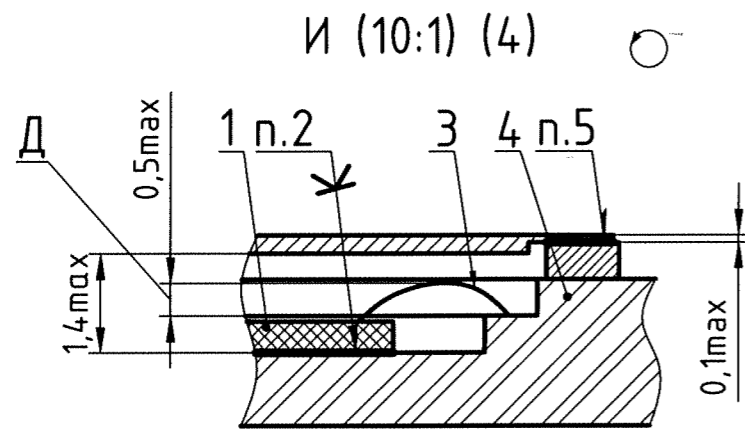
Регистрационный номер карты заказа



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1589	Л.Ф. до. 01. 01. 2019			

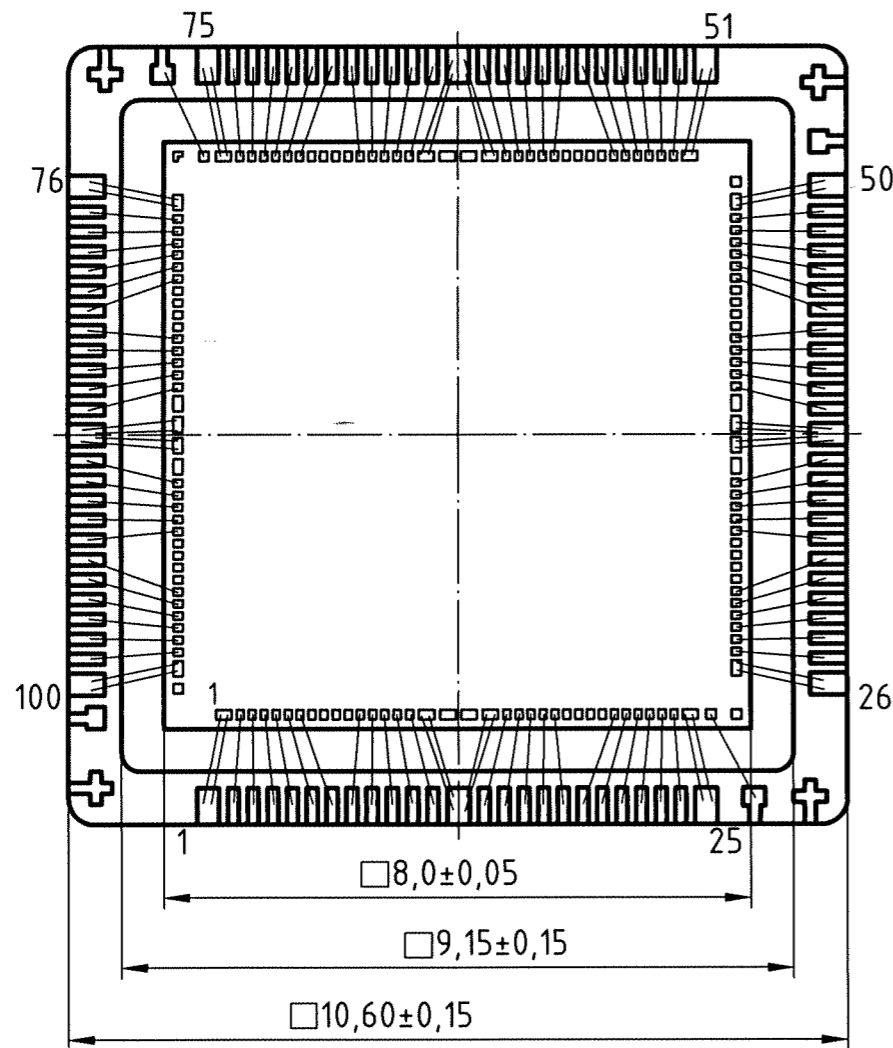
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>Сид</i>	09/2019
Изм./Лист	№	Докум.	Подп.	Дата

Рис.2 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.016-01)

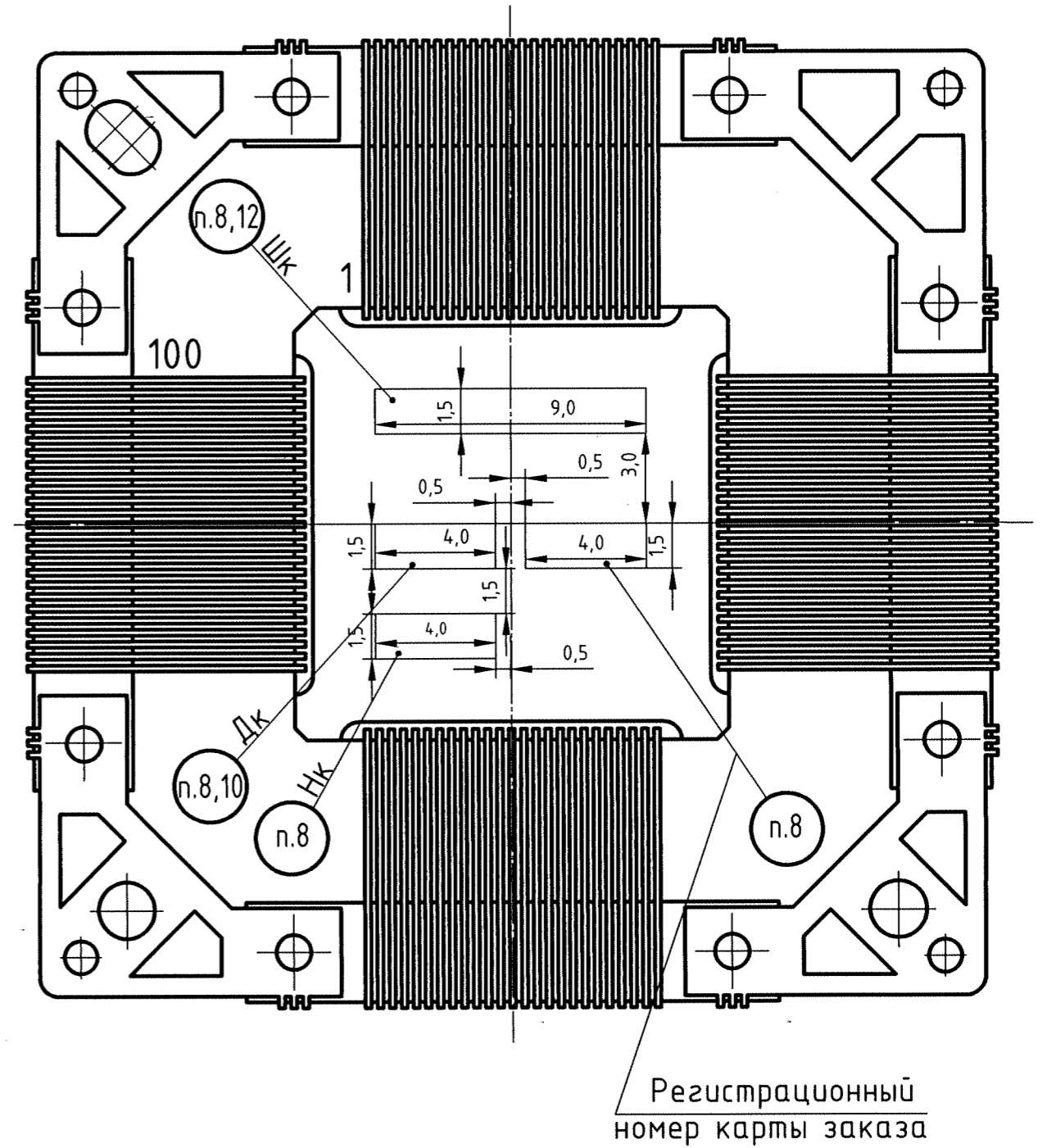


Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны

Е (10:1) (4)



Ж (4) (4)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1569	Def 01.01.20			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019		
Изм./Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	